

УЧЕБНАЯ (ПРОЕКТНАЯ) ПРАКТИКА

1. Цели проведения практики

Формирование готовности использовать знания о принципах построения и функционирования электронных устройств и компьютерной техники в образовательной и профессиональной деятельности.

2. Место практики в структуре ОПОП

Для прохождения практики «Учебная (проектная) практика» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Иностранный язык», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Педагогика», «Психология», «Речевые практики», «Электротехника», прохождения практик «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная практика (технологическая)».

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика», «Философия», «Финансовый практикум», «Актуальные проблемы физического образования», «Астрономия», «Досуг подростков как сфера воспитания», «Инновационные технологии обучения физике», «История естествознания и техники», «Квантовая механика», «Конфликты в педагогической деятельности», «Методы и технологии решения физических задач», «Микроэлектроника», «Практическая физика», «Психологические основы педагогической работы с детьми с трудностями обучения», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Статистическая физика», «Физика колебаний», «Физика неравновесных систем», «Физика ядра и элементарных частиц», «Школьный физический эксперимент», «Электронные процессы в твердых телах», прохождения практик «Преддипломная практика», «Производственная (тьюторская)», «Учебная (методическая) практика».

3. Требования к результатам прохождения практики

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);
- владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, методами организации и постановки физического эксперимента, теорией и практикой организации физического образования (ПКР-2).

В результате прохождения практики обучающийся должен:

знать

- физические основы полупроводниковой микроэлектроники, основные понятия, характеристики и параметры микроэлектронных приборов, основные явления и процессы,

используемые при построении элементов ИС;

– принцип работы, схемотехническую реализацию логических и базовых элементов, узлов ЭВМ, основы реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств, микропроцессоров;

уметь

– объяснять физическую сущность явлений и процессов в элементах микроэлектроники, функциональное назначение основных узлов электронных устройств, ориентироваться в современных тенденциях развития микроэлектроники;

– проводить исследование элементов и узлов ЭВМ: триггеров, счетчиков, регистров памяти, ЦАП и др;

владеть

– навыками построения простейших принципиальных, и структурных схем устройств ЭВМ;

– навыками выполнения электрических измерений параметров ИС, навыками использования знаний для организации и проведения экспериментального исследования с применением современного электронного оборудования.

4. Объём и продолжительность практики

количество зачётных единиц – 3,

общая продолжительность практики – 2 нед.,

распределение по семестрам – 4.

5. Краткое содержание практики

Физические основы полупроводниковой микроэлектроники и принципы построения микроэлектронных приборов и устройств.

Полупроводниковые диоды, стабилитроны, тиристоры симисторы. Физические процессы в биполярном и полевом транзисторах. МДП транзисторы. Светодиоды, фотодиоды, фототранзисторы и фототиристоры. Интегральные микросхемы, степень интеграции, частотные и мощностные характеристики разных типов логик. ЧИПы. Элементы алгебры логики, основные теоремы булевой алгебры и логические функции. Элементы комбинационной логики: ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Условные обозначения элементов и их схемотехническая реализация на дискретных элементах и в интегральном исполнении. Ключ на биполярном транзисторе, схема, построение передаточной характеристики. Ключ на КМОП транзисторах, передаточная характеристика. Основные характеристики базовых логических элементов. Схема, принцип действия базового элемента И-НЕ транзисторно-транзисторной (ТТЛ) логики. Базовые элемент на МДП и КМДП транзисторах. Элементы последовательностной логики, триггеры. Генераторы и формирователи импульсов.

Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных ЭВМ, принципы их работы и функционирования.

Переход от таблицы истинности логического устройства к структурной формуле и схеме цифрового устройства. Применение методов цифровой электроники для разработки электронных схем. Цифровые автоматы – дешифратор, мультиплексор. Иерархия запоминающих устройств ЭВМ. Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) статического и динамического типа. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). Принцип устройства ПЗУ с пережигаемыми перемычками, с ультрафиолетовым и электрическим стиранием информации. Флеш память, кеш память. Краткая история развития и становления микропроцессоров. Блок схема и принцип взаимодействия блоков микропроцессора. Система команд микропроцессора.

6. Разработчик

Сыродоев Геннадий Алексеевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики и физики ФГБОУ ВО "ВГСПУ",
Глазов Сергей Юрьевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики и физики ФГБОУ ВО "ВГСПУ".